Comment créer son idHAL ?

https://doc.archives-ouvertes.fr/compte-et-profil/

« J'ai déjà un compte HAL ! Pourquoi ai-je besoin d'un IdHAL ? » Le compte HAL sert à se connecter sur la plateforme et à faire des dépôts de documents à l'aide d'un login et d'un mot de passe. L'IdHAL est un identifiant auteur unique, différent du login. Il permet de rattacher une production à un seul profil auteur.

Se connecter à son compte HAL sur <u>https://hal.archives-ouvertes.fr/</u> ou faire un demande de compte sur la <u>page de connexion</u>.

Lors d'une première connexion, on vous demande de paramétrer vos préférences de dépôt. Si vos affiliations automatiques sont à jour, passez à l'étape 3 création de l'idHAL.

1. Préférences de dépôt

Dans l'onglet Mon espace/mon profil, sélectionner les préférences de dépôt et faire vos choix.

Informations de mon profil HAL					
·					
Préférences de dépôt					
Préférences de réception de cour	riel				

Accu Modi	ueil Dépôt Consultation - Recherc	che Documentation Mon espace -		
	ification de votre compte		0	
Vou	us pouvez modifier ici vos préférences de dépôt es préférences de dépôt			choisir une vue détaillée
choisir «oui» pour que	Les informations choisies ci-dessous apparaîtron Formulaire de dépôt g	t par defaut à chaque nouveau dépôt. Elles seront modifiables lors de votre dépôt. En sue simple n'apparaissent que les métadonnées obligatoires. Vous pouvez naviguer entre les 2 sues lors de votre dépôt.		permet d'ajouter un projet ANR / européen, un résumé, un id ArXiV,
automatiquement renseignées lors des dépôts	Domaines M'ajouter comme auteur	Sciences de Ingénieur (physics) Afficher la liste des domaines Doit-on vous associer automatiquement comme auteur de vos nouveaux dépôts ? Out O Non		Sciences pour l'Ingénieur sera rentré par défaut lors des dépôts
Sélectionnez l'affiliation IEMN (id : 1066983) et groupe . Ex : CMNF - IEMN	Affiliation(s)	Veullez sasir le nom ou l'acronyme de votre laboratoire et le sélectionner dans la liste IEMN INITUR d'Electronique, de Microellectronique et de Nanotechnologie (EAN) - UNR 8520 Saki (201) Contra de la Recherche Schertifique - Offic Contra haloait de la Recherche Schertifique - JURA JANG CONF		

Affiliation(s) Affilier les auteurs automatiquement	Veuillez saisir le nom ou l'acronyme de votre laboratoire et le sélectionner dans la liste Castrale de Micro Nano Fabrication - IEMN (CMI 5-IEMN (CO21) (1954/60) X Institut d'Electronique, de Microlectronique et de Nanotechnologie (EMN) - UMR 52/0 IEMN (CO21) (1968/2) X Il est recommandé de vérifier les affiliations automatiques des auteurs déduites à partir du document déposé.	activer l'affiliation automatique co-auteurs. Toujours vérifier les propositions faites par HAL
	Enregistrer les modifications	

2. Préférences de réception de courriel

HAL	
Informations de mon profil HAL	
Préférences de dépôt	Pour être automatiquement averti par courriel dès qu'un dépôt est mis en ligne, cochez la/les case(s)
Préférences de réception de courriel	Recevoir la confirmation de vos dépôts
Recevoir la confirmation de vos dépôts Oui	Recevoir les notifications lorsque vous êtes
Recevoir les notifications lorsque vous Oui étes identifié comme co-auteur	identifié comme co-auteur
✓ Modifier mes préférer	ices de courriel

Bien activer la case « recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme auteur » : vous êtes ainsi averti par un mail vous permettant de valider que vous en êtes bien co-auteur : ce dépôt est alors présent dans votre espace et vous pourrez le modifier/le compléter.

3. Création de l'idHAL :

Dans l'onglet Mon espace/mon profil/informations de mon profil HAL

CCSD HAL - Episciences.org - Sciences.conf.org Support	• • • • • • •	🕈 🔲 Salha Ouendi +
	Mon espace / Mon profit	
	CCSD	
	Hamadara da nan a prodición da nan a produción da	
	HAL	
	Informations de mon profil HAL	
	Veen noon dates NAL : Ealth Council Mon tail : Concernool 1890 • Cliquer sur créer mon idHAL Lange : Varyes Modifier mon pool	
	Préférences de dépôt	
	Préférences de réception de courriel	

Choisir la chaine de caractères souhaitée pour l'idHAL (par défaut : prénom-nom).

CCSD HAL	L - Episciences.org - Sciencesconf.org	Support	- A	fr	🔲 Saliha Ouend
	Accueil Dépôt Consultation - Re	cherche Documentation Mon espace -	THE S		
	Regroupez vos formes auteurs et créez votre Id	łAL			
	Identifiants	•			
	IdHAL	Attention, cet identifiant ne pourra plus être modifié par la suite saliha-ouendi	idHAL suggéré		
	Autres identifiants chercheur	Alignez votre ldHAL avec vos autres identifiants chercheurs		arXiv• 🕇	arXiV,
	Uris de réseaux sociaux	Ajoutez vos liens vers les réseaux sociaux		arXiv VIAF	

Vous pouvez indiquer si vous le souhaitez d'autres identifiants chercheur (arXiV, idRef,...).

Synchroniser avec votre ORCID : prévoir vos identifiants de connexion à orcid.org

Puis, rattacher des formes auteurs présentes sur HAL à votre idHAL en tapant les formes (ex : nom de famille) dans la barre de recherche:

Mes formes au	teur		
Mes forme	s auteur		
Forme préférée 😡			
۲	Ghizlane Boussatour		formes
0	Ghizlaine Boussatour	ŧ	auteurs. Sélectionner
Ajouter une forme :	Boussatour		pour ajouter
	Ajouter une nouvelle forme		
	G. Boussatour		

Reproduire l'opération avec différentes graphies, pour ratisser large on peut taper uniquement le nom de famille. Choisir la forme par défaut à afficher. Une fois toutes les formes sélectionnées passez à l'étape suivante : mes publications.

Cliquer sur « voir les publications avec vos formes auteurs »



Cocher tous les documents pertinents, décocher les références qui ne sont pas les vôtres (homonymes,...) et cliquer sur ajouter :

×

Ajouter des publications

	Amine Abdelkader Guermoudi, Pierre-Yves Cresson, Amaria Ouldabbes, Ghizlane Boussatour, Tuami Lasri. Thermal conductivity and interfacial effect of parylene C thin film using the 3-omega method. <i>Journal of Thermal Analysis and</i>	Ghizlane Bouss 🗸
	Calorimetry, Springer Verlag, 2021, 145 (1), pp.1-12. (10.1007/s10973-020-09612-z). (hal-03322499)	
「幸」	Ghizlane Boussatour. Caractérisation diélectrique et thermique de films biopolymères pour l'électronique flexible haute fréquence. Micro et nanotechnologies/Microélectronique. Université de Lille, 2019. Français. (NNT : 2019LILUI015). (tel-03622465)	Ghizlane Bouss v
	Ghizlane Boussatour, Pierre-Yves Cresson, Benoit Genestie, Nicolas Joly, T. Lasri. Characterization of biodegradable and biosourced polylactic acid (PLA) substrate in a wide frequency range (0.5-26 GHz). 2017 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications (IMWS-AMP). Sep 2017, Pavia, Italy. pp.1-3, (10.1109/imws-amp.2017.8247428). (hal-03263973)	Ghizlane Bouss v
•	Ghizlane Boussatour, Pierre-Yves Cresson, Benoit Genestie, Nicolas Joly, Jean-François Brun, et al Measurement of the thermal conductivity of flexible biosourced polymers using the 3-omega method. <i>Polymer Testing</i> , Elsevier, 2018, 70, pp.503-510. (10.1016/j.polymertesting.2018.07.026). (hal-02625518)	Ghizlane Bouss v

Confirmez : les publications en vert seront conservées et les publications en rouge rejetées du profil

ublications ajoutées	
ublications retirées	
	substrate in a wide frequency range (0,5-26 GHz). 2017 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications (IMWS-AMP), Sep 2017, Pavia, Italy. pp.1-3, (10.1109/imws-amp.2017.8247428). (hal-03263973)
Ghizlane Boussatour	Ghizlane Boussatour, Pierre-Yves Cresson, Benoit Genestie, Nicolas Joly, Jean-François Brun, et al Measurement of the thermal conductivity of flexible biosourced polymers using the 3-omega method. <i>Polymer Testing</i> , Elsevier, 2018, 70, pp.503-510. (10.1016/j.polymertesting.2018.07.026). (hal-02625518)
Ghizlane Boussatour	Yannick Dusch, Cécile Ghouila-Houri, Aurélien Mazzamurro, Ghizlane Boussatour, Hatem Dahmani, et al Mise en œuvre de capteurs RF-MEMS acoustiques pour l'industrie 4.0. <i>16emes journées pédagogiques du CNFM, JPCNFM'2021</i> , CNFM, Dec 2021, Saint-Malo, France. 6 p., J3eA Hors-série 1 - Actes JPCNFM'2021, Volume 21 (2022), (10.1051/j3ea/20221019). (hal-03464507)

Fin de la création de l'idHAL.